

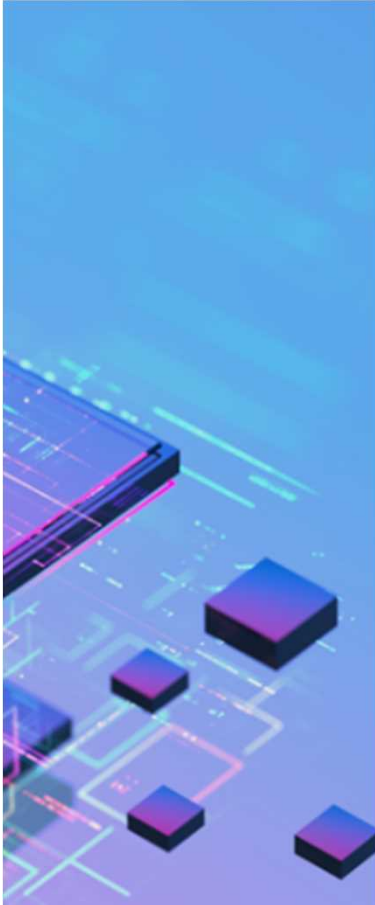


株式会社 アルバック

2025年6月期 第3四半期 決算説明資料

2024年7月～2025年3月

2025年5月13日



将来見通し等に関する記述についての注意事項

■ 将来見通しについて

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

■ 数字の処理について

本資料に記載の数字・比率につきましては、単位未満四捨五入で処理しております。

■ 品目名称変更について

2025年6月期より、FPD製造装置の名称をディスプレイ・エネルギー関連製造装置に変更しております。

2025年6期 第3四半期

業績進捗

- 外部環境の変化等を背景に、売上高/各利益項目が減少するも
売上総利益率 3Q：33.3%、前3Q累計比：+1.2ptと着実に上昇

通期予想
下方修正

- EV関連ビジネス鈍化等による受注高減少等に伴い、通期業績予想を下方修正
- 株主還元重視による安定配当の観点から、**配当は従来予想を据え置き**

今後の方針と施策

今後の方針/
施策

- 外部環境の変化等により、2026年6月期を最終年度とする現中期経営計画の目標達成が困難と判断し、現中期経営計画の廃止決定。**持続的な成長を確実にするために抜本的な改革を断行**、2026年6月期を初年度とする**新中長期経営計画“バリューアッププラン”**をスタート(8月開示)
- **経営資源の最適化を断行、半導体電子中心の事業ポートフォリオへの見直しを加速**させ高成長/高収益性を実現し、企業価値を高めることで資本市場における評価向上を目指す



2025年6月期 第3四半期連結業績

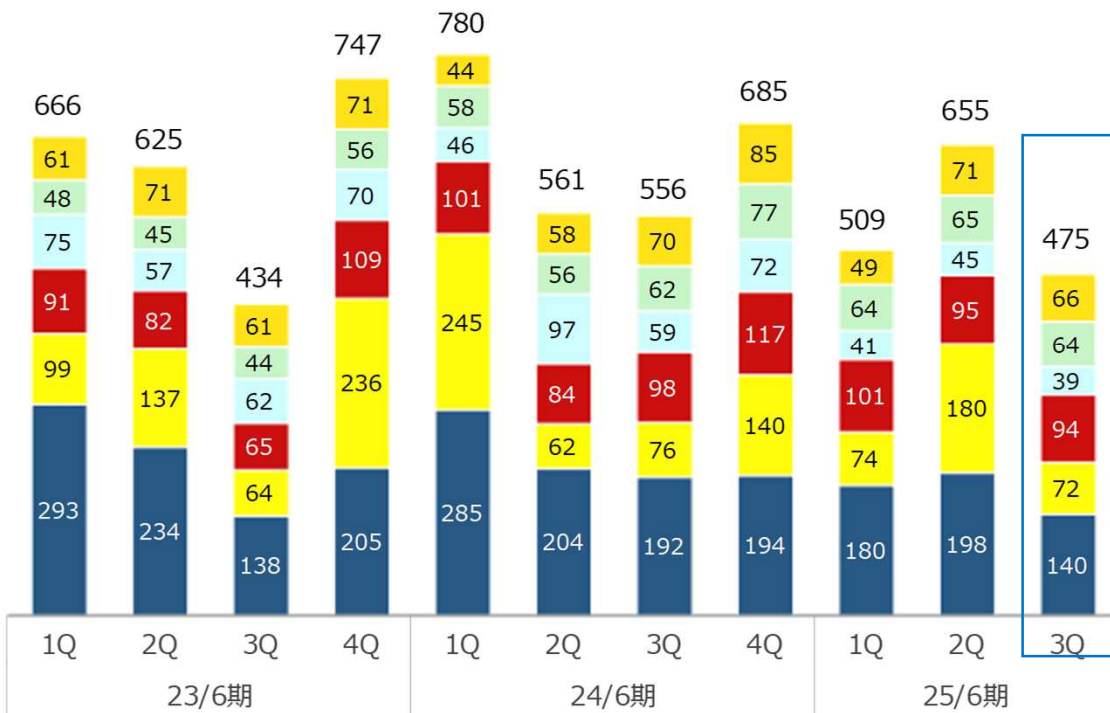
【単位：億円】	2024/6期						2025/6期					前年同期比	
	1Q	2Q	3Q	3Q累計	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	3Q累計			
受注高	780	561	556	1,897	685	2,582	509	655	475	1,639	-258	-14%	
売上高	550	652	650	1,852	759	2,611	610	739	529	1,877	+25	1%	
売上総利益	153	201	220	574	233	807	191	238	176	605	+31	5%	
率	27.7%	30.8%	33.8%	31.0%	30.7%	30.9%	31.3%	32.2%	33.3%	32.2%	+1.2pt		
販管費	124	126	119	369	139	509	134	142	122	398	+29	8%	
営業利益	28	75	101	204	94	298	58	96	54	208	+4	2%	
率	5.1%	11.5%	15.5%	11.0%	12.3%	11.4%	9.4%	13.0%	10.2%	11.1%	+0.0pt		
経常利益	29	81	95	205	93	298	69	92	61	221	+17	8%	
率	5.3%	12.4%	14.6%	11.1%	12.3%	11.4%	11.3%	12.4%	11.5%	11.8%	+0.7pt		
親会社株主に帰属する 四半期純利益	11	57	64	132	69	202	37	67	27	131	-1	-1%	
率	2.1%	8.8%	9.9%	7.1%	9.1%	7.7%	6.1%	9.0%	5.1%	7.0%	-0.2pt		

- ≫ 3Q受注高減少等に伴い、3Q売上高・各利益項目減少も、売上総利益率は33.3%と着実に上昇
- ≫ 前3Q累計比で売上総利益率+1.2ptと利益率ベースは着実に改善

受注高

【単位：億円】

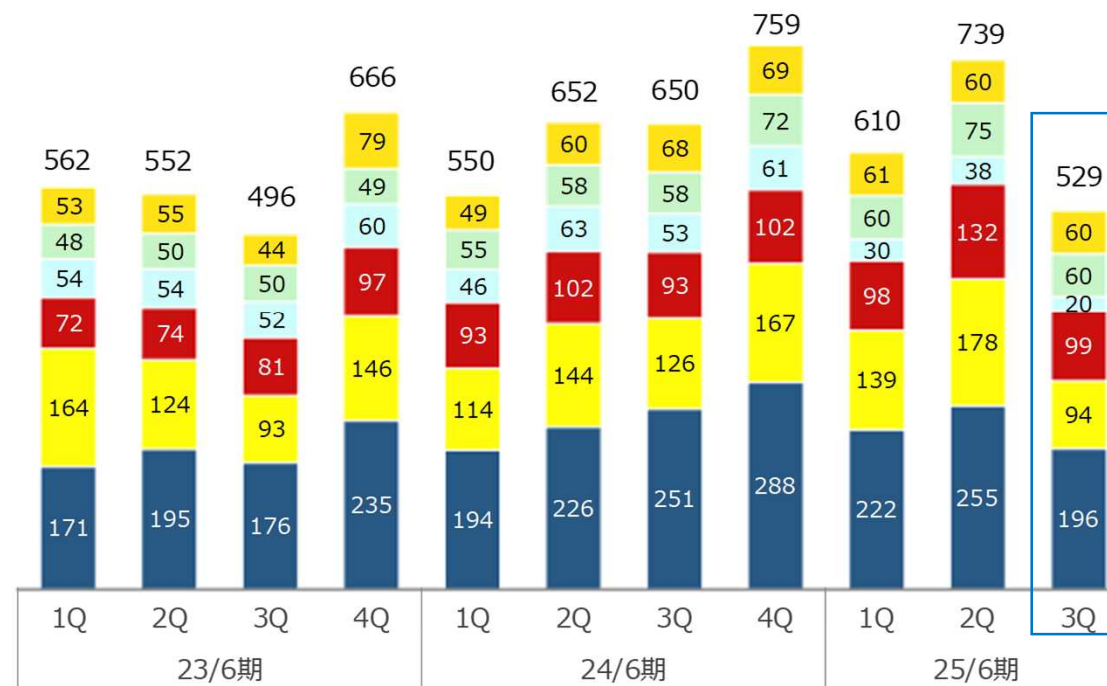
■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ マテリアル
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



売上高

【単位：億円】

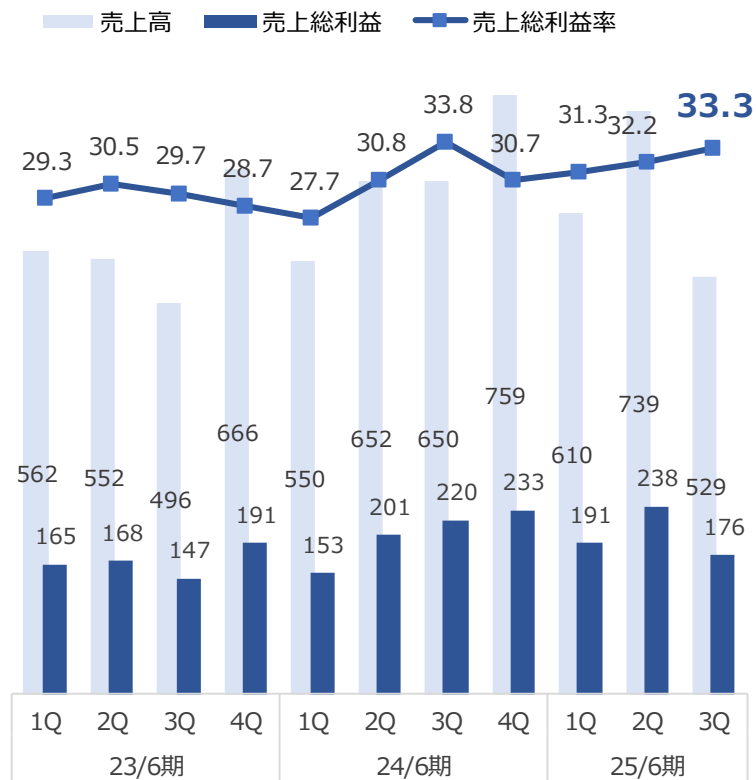
■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ マテリアル
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



- ≫ **【受注高】 2Q比▲180億円：2Q・OLED案件の反動減、パワーデバイス・バッテリー等の弱含み継続**
- ≫ **【売上高】 2Q比▲210億円：3Q受注減少等の影響で売上高減少**

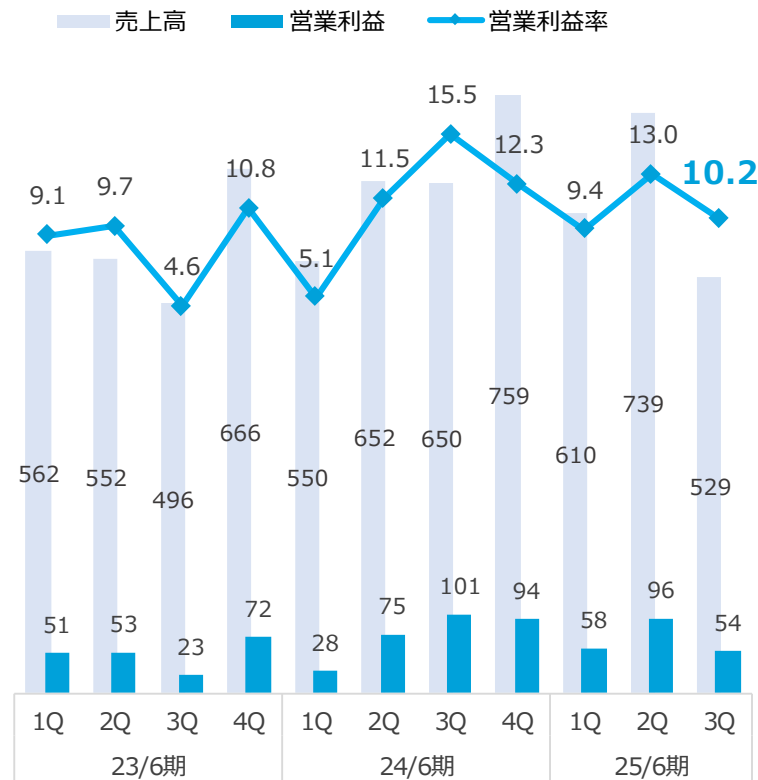
売上総利益率

【単位：億円、%】



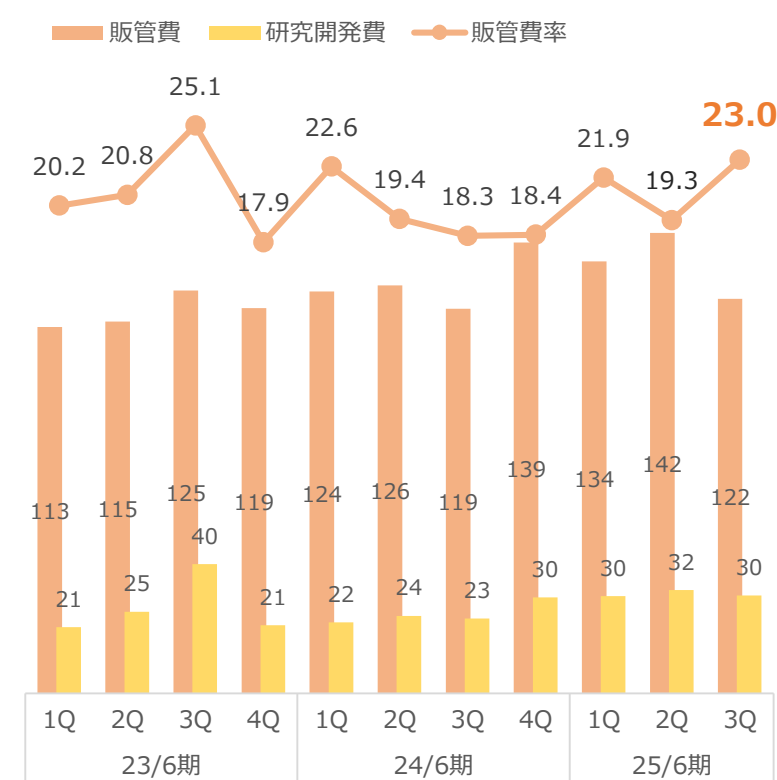
営業利益率

【単位：億円、%】



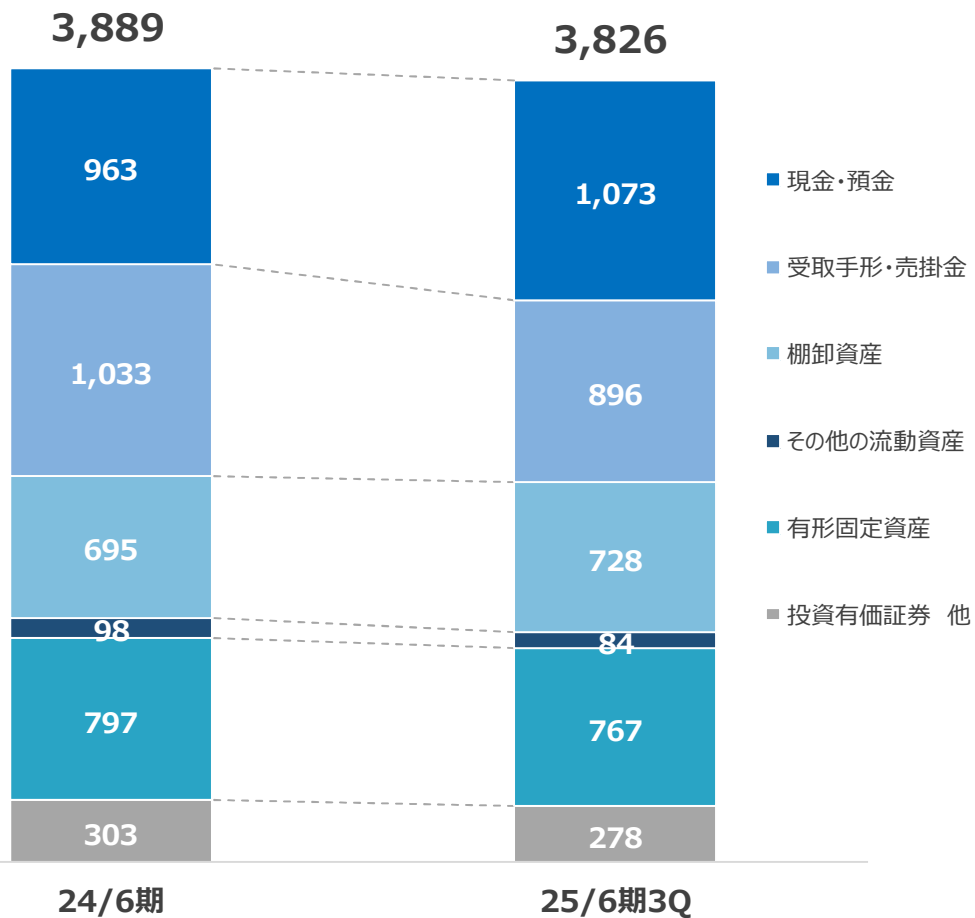
販管費率

【単位：億円、%】

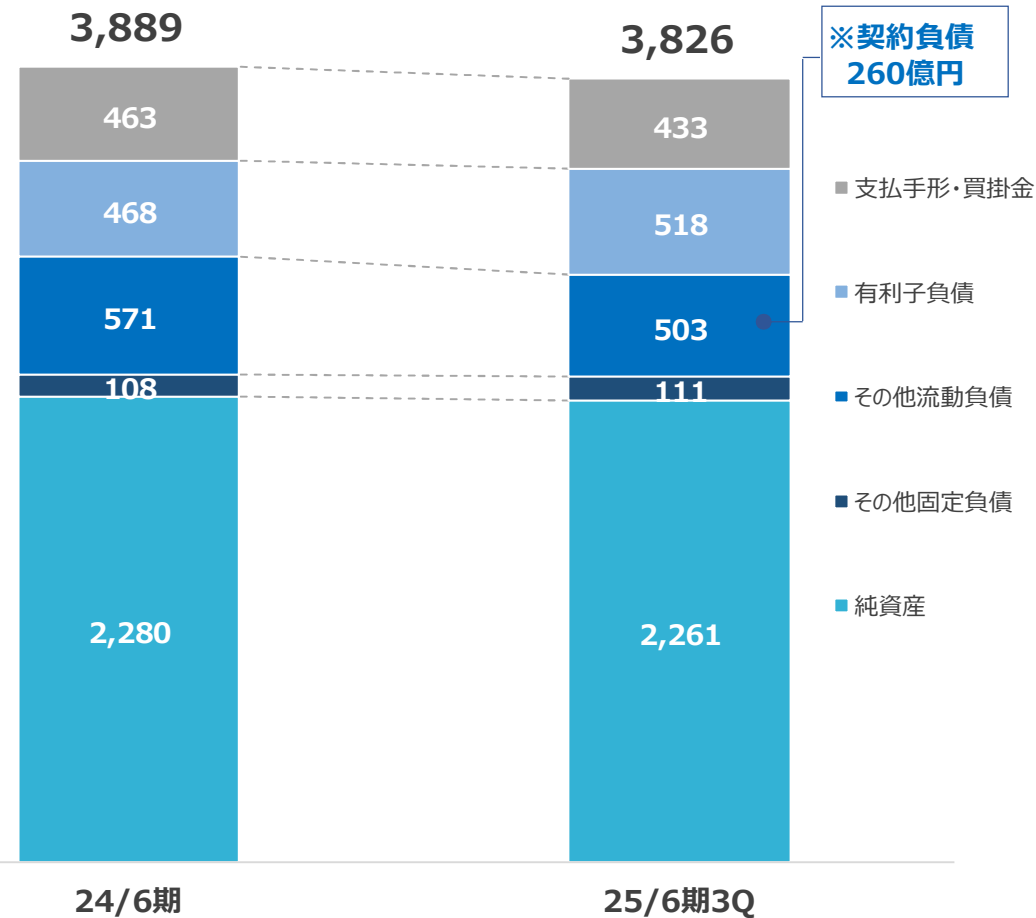


- » 売上総利益率：3Q売上高減少も、ミックス改善・高利益率案件の寄与等で売上総利益率33.3%達成
- » 営業利益率：売上高減少に伴い、営業利益率低下

資産 【単位：億円】



負債・純資産 【単位：億円】





2025年6月期 業績予想

2025/6期 業績予想の修正

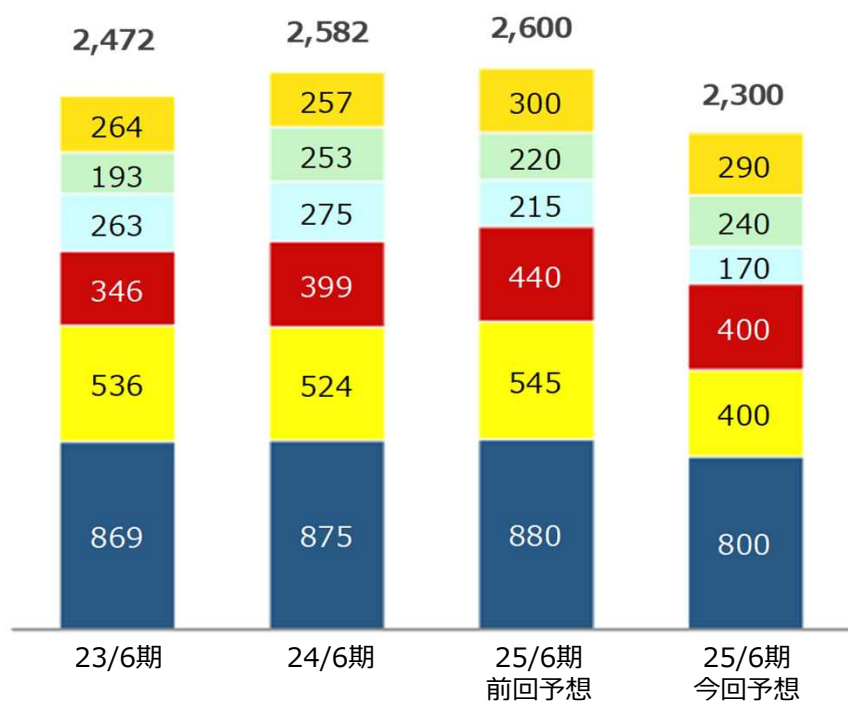
【単位：億円】	24/6期	25/6期					
	通期実績	前回予想	通期予想	前回予想比		前年同期比	
				増減額	増減率	増減額	増減率
受注高	2,582	2,600	2,300	-300	-12%	-282	-11%
売上高	2,611	2,750	2,500	-250	-9%	-111	-4%
売上総利益	807	890	800	-90	-10%	-7	-1%
率	30.9%	32.4%	32.0%	-0.4pt	-	+1.1pt	-
営業利益	298	345	270	-75	-22%	-28	-9%
率	11.4%	12.5%	10.8%	-1.7pt	-	-0.6pt	-
経常利益	298	350	275	-75	-21%	-23	-8%
率	11.4%	12.7%	11.0%	-1.7pt	-	-0.4pt	-
親会社株主に帰属する 当期純利益	202	230	170	-60	-26%	-32	-16%
率	7.7%	8.4%	6.8%	-1.6pt	-	-0.9pt	-
1株あたり配当金（円）	144	164	164	0		+20	

- ≫ **受注高：EV関連ビジネス鈍化等で受注高見込みを2,300億円に見直し**
- ≫ **売上高・各利益(率)：受注高減少に伴う通期予想を修正も、売上総利益率は32%と改善を見込む**
- ≫ **株主還元重視による安定配当の観点から、配当は従来予想を据え置き**

受注高

【単位：億円】

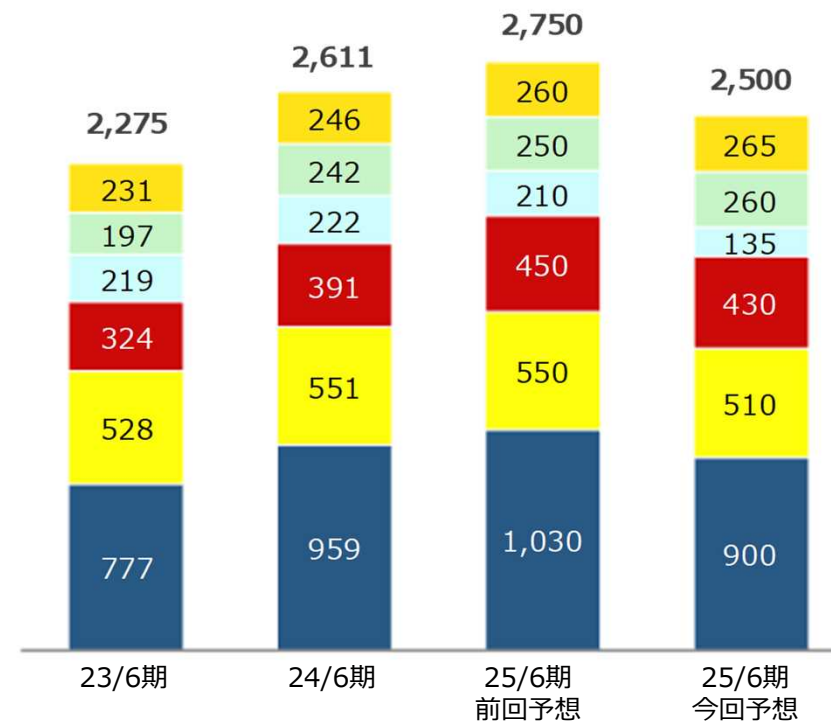
■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ マテリアル
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



売上高

【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ マテリアル
■ ディスプレイ・エネルギー関連製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



- » 受注高：パワーデバイス・バッテリービジネス等の投資減速により減少
- » 売上高：期中受注→期中売上計上予定分が来期への期ずれにより減少

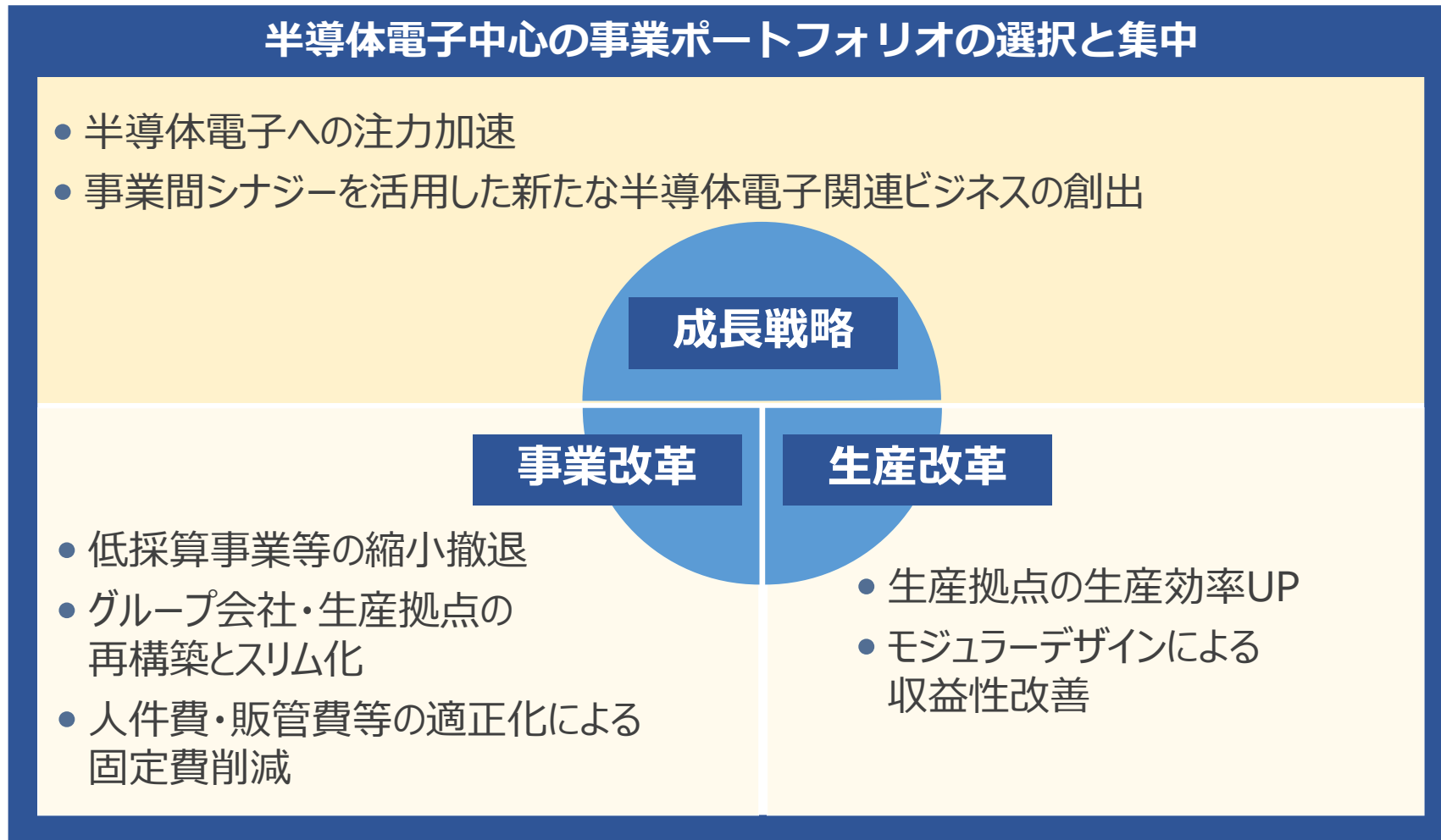
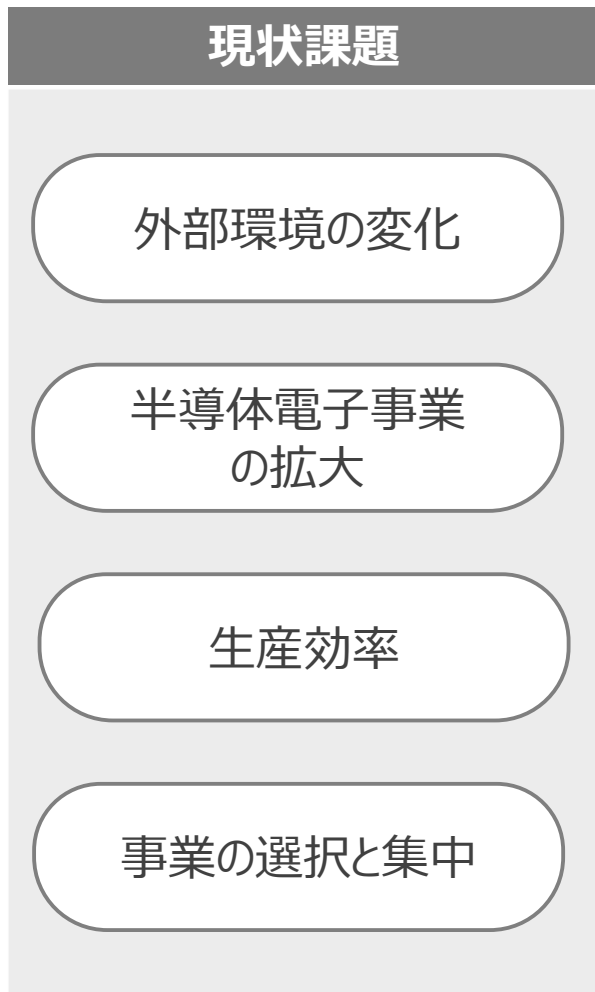
品目	市場環境・投資動向	CY25
半導体 ロジック・メモリ	<ul style="list-style-type: none"> DRAM：スマホ・AI需要による回復、HBM関連投資継続 NAND：ストレージ需要・生成AI関連需要による拡大期待 先端ロジック：次世代ノードに向けた投資本格化 	
各種電子デバイス	<ul style="list-style-type: none"> 生成AI向けWLPビジネス拡大 PLP開発投資活発化 	
パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none"> EV需要鈍化・8inchSiCへの切り替えタイミングで投資減速も中長期に成長 	
ディ스플레이	<ul style="list-style-type: none"> タブレット・車載向けOLED実現に向けた設備追加・改造案件による持続的貢献 	
バッテリー関連	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーメーカーによるアルミ両面蒸着膜の試用増加も、量産転換は依然鈍化。銅両面蒸着膜・リチウム膜等で中長期的な成長期待 	
コンポーネント・一般産業・ マテリアル・その他	<ul style="list-style-type: none"> 半導体電子等における各種設備投資の活発化に伴い、安定基盤ビジネスとして堅調に推移 先端デバイス等の研究開発活発化に伴う表面分析装置好調 	



新中長期経営計画 概要 ～ バリューアッププラン ～

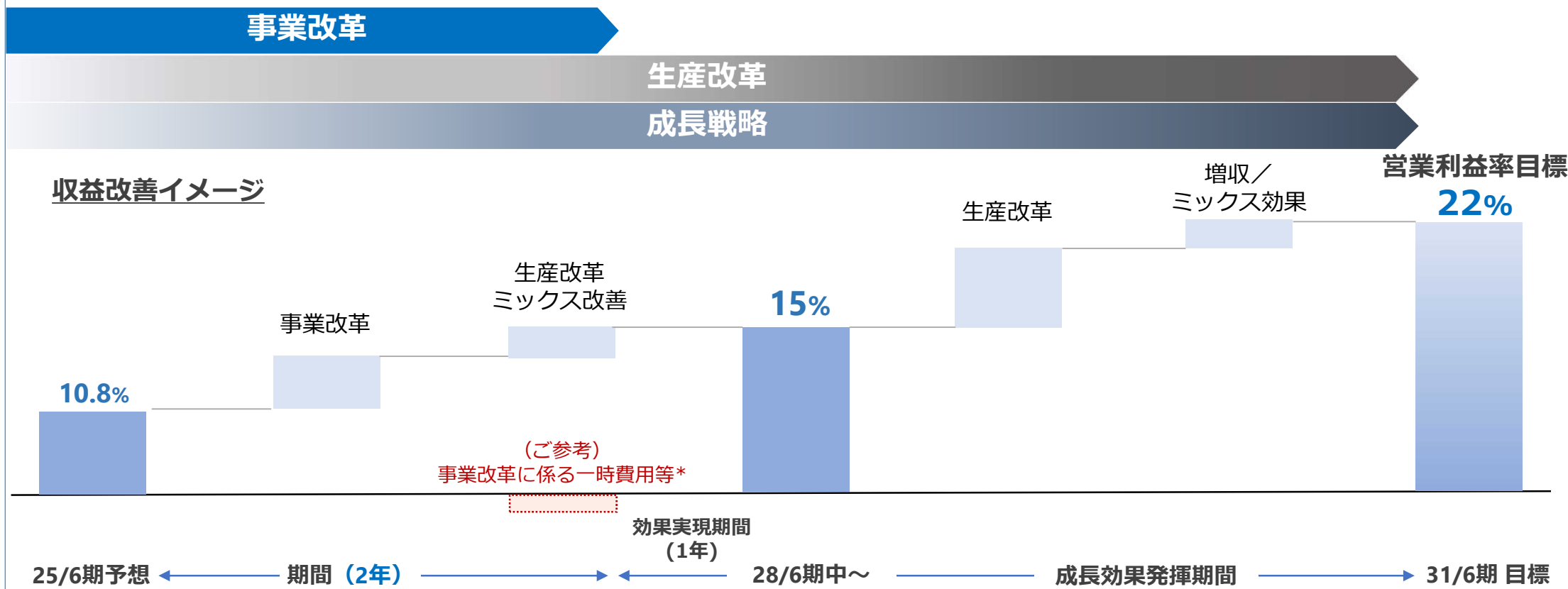
» 経営資源の最適化を断行、半導体電子中心の事業ポートフォリオへの見直しを加速させ高成長/高収益性を実現することで、企業価値を高め資本市場における評価向上を目指す

■ 筋肉質な経営/収益体制を目指したバリューアッププランを新たに策定



- 持続的な成長を確実にするためには、足もとの事業改革が必要と判断
- 「事業改革」「生産改革」「成長戦略」からなる**6年間**の中長期経営計画を策定

- 2年間で事業改革を断行、経営資源の最適化施策を完遂することで筋肉質で強靱な経営体質を構築
- 3年目から本格的な効果を発揮、持続的な成長を確実にすることで高成長/高収益性の実現を目指す



*27/6期迄に生じる当期純利益への影響として一時費用（営業外）が発生する可能性があるため、試算を進める予定

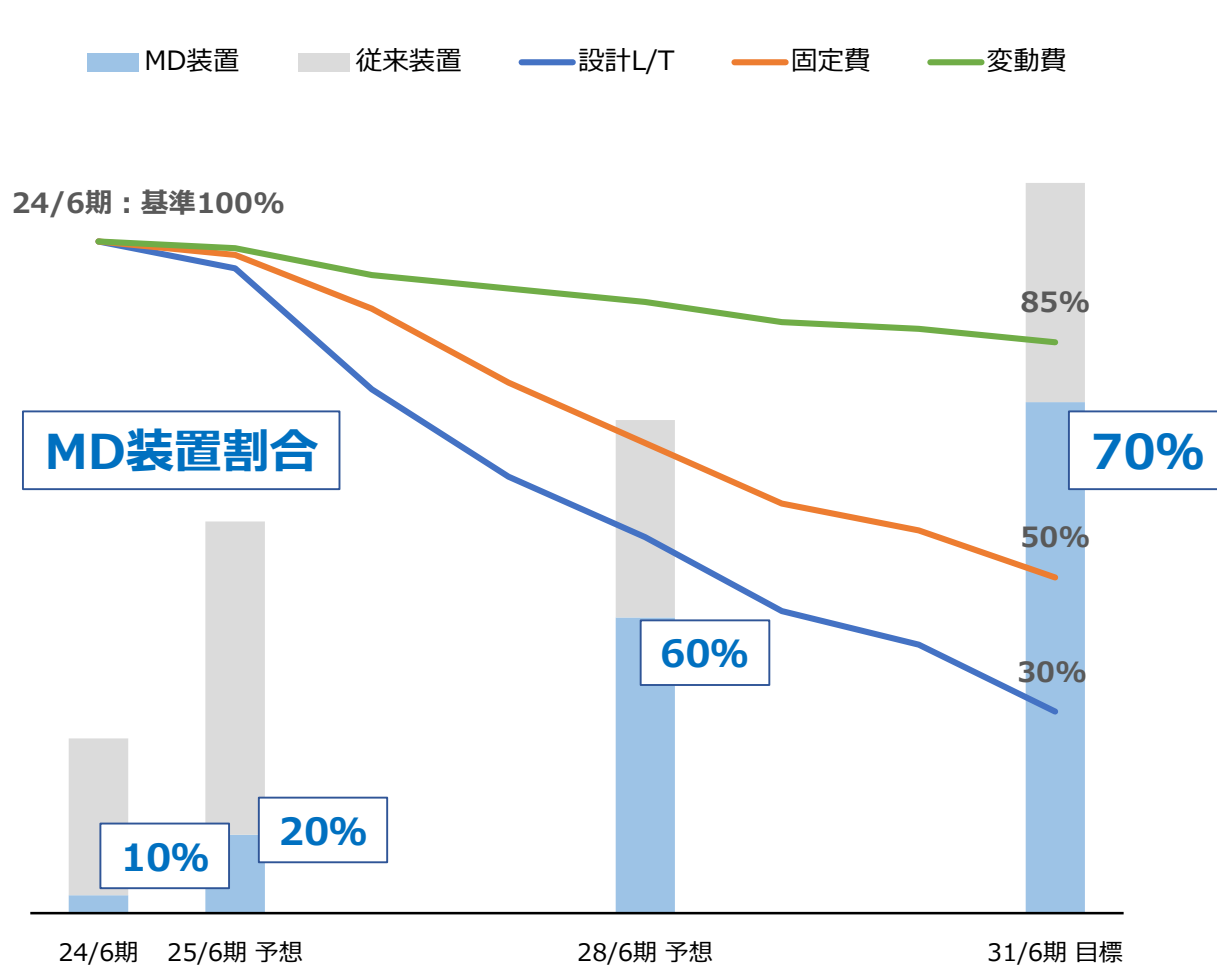
- 27/6期までの**2年間**で経営資源の最適化施策を完遂
- FPD関連事業を含む事業ポートフォリオ見直しによる選択と集中
- 28/6期初からの収益率寄与を想定

事業改革

1年目～2年目

- 低採算事業等の縮小撤退
- グループ会社・生産拠点の再構築とスリム化
- 人件費・販管費等の適正化による固定費削減

- ▶ 半導体電子中心のモジュラーデザイン装置割合を高め顧客ニーズに迅速に対応し、収益性改善を実現
- ▶ これまで生産システムの見直し、MD*1化の仕組み構築等を進めてきたことで25/6期から効果が出始めており、確実に生産性向上が見込める状態に



*1 MD : Modular Design *2 L/T : Lead Time

(設計)

Modular Design (MD)

↓

設計L/T
70%減

設計工数圧縮、L/T*2短縮

- ・ 図面を変えない組合せ（互換性のある設計）で顧客仕様を実現

(調達・生産)

計画的生産

↓

変動費率
15%減

調達L/T短縮、変動費(率)圧縮

- ・ 部品共通化と計画的まとめ発注で部品価格Down
- ・ 組立予定に合わせた部品調達

(製造・TEST)

標準組立

↓

固定費率
50%減

製造L/T短縮、出荷台数Up、固定費(率)圧縮

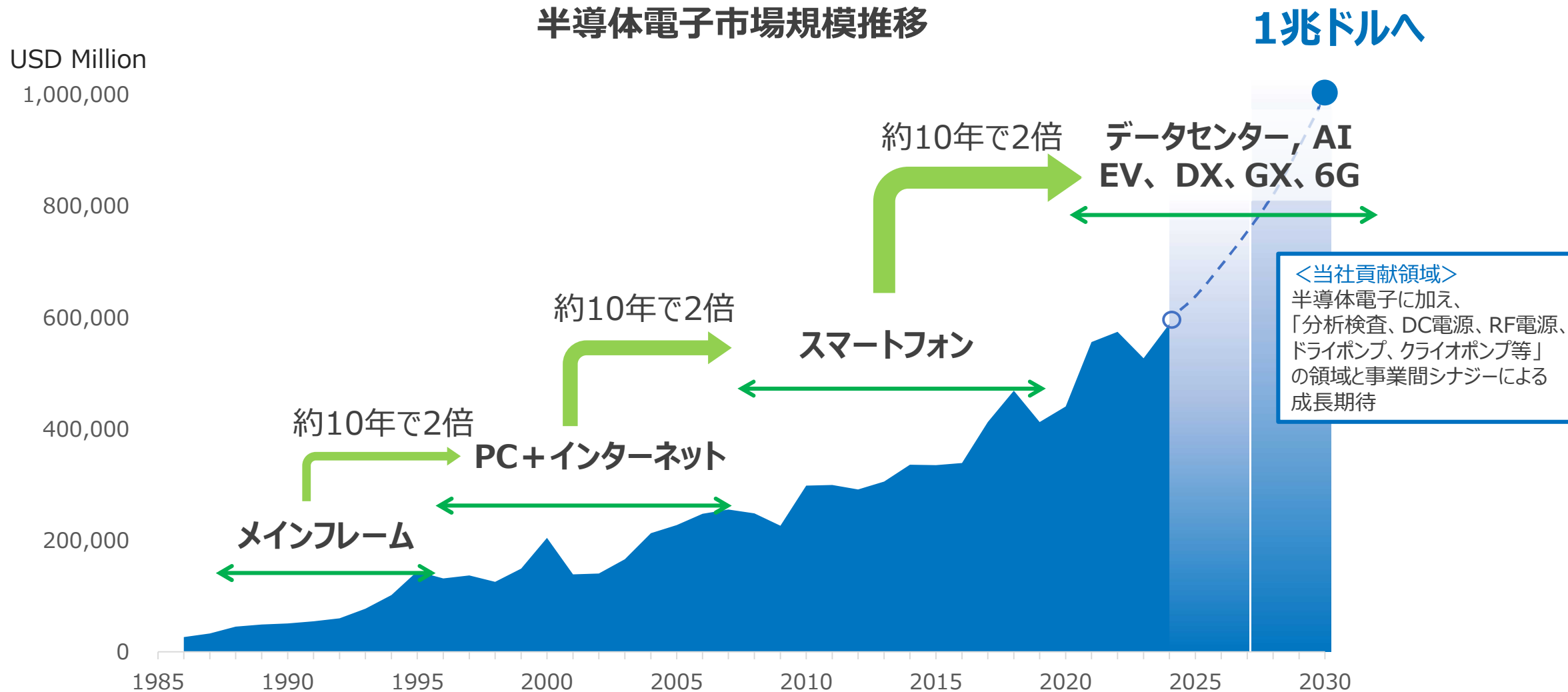
- ・ 標準組立と計画生産で生産最適化

» 持続的な成長を確実にするため、事業ポートフォリオを強化し、高成長/高収益性を目指す

半導体電子
中心に
更なる成長

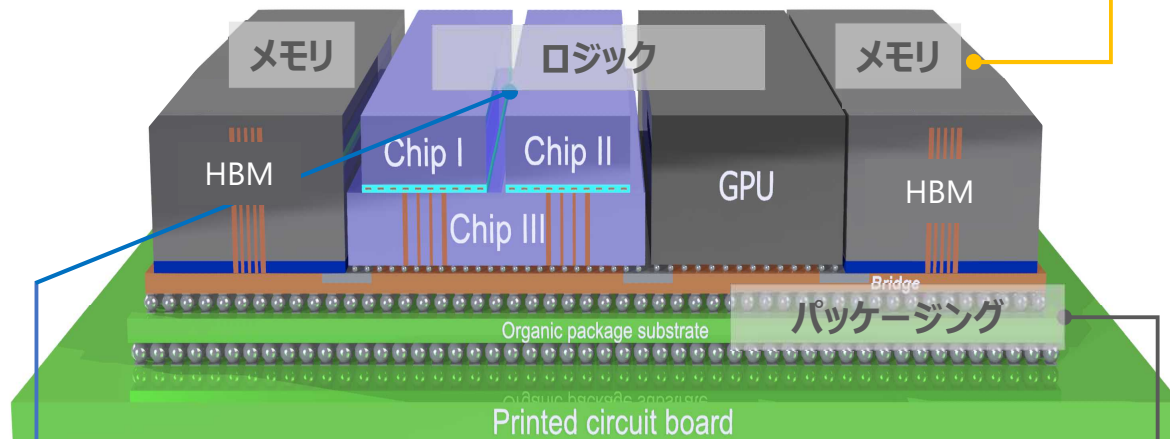
- 事業間シナジーを活用した
新たな半導体電子関連ビジネスの創出
- 半導体/電子事業の成長加速
- AI関連ビジネス拡大の取り組み

半導体電子市場は2030年に1兆ドルへ成長



出所：WSTS、SEMI

先端AI半導体パッケージ



メモリ（DRAM・NAND）向けビジネス

- HBM周辺工程：金属再配線層の拡大
- 配線加工：微細化に伴うDRAMでのMHM採用
- 低抵抗配線：低抵抗/新材料展開

取り組み効果：受注高3.6倍*

ロジック・ファブ向けビジネス

- TiN MHM：先端から成熟Nodeまで幅広く採用
- HM応用技術：機能膜・FEOL加工への波及
- HM line Up: TiN MHM以外の工程獲得
- 金属配線層：先端Logicでの配線工程獲得

取り組み効果：受注高 2.4倍*

パッケージング向けビジネス

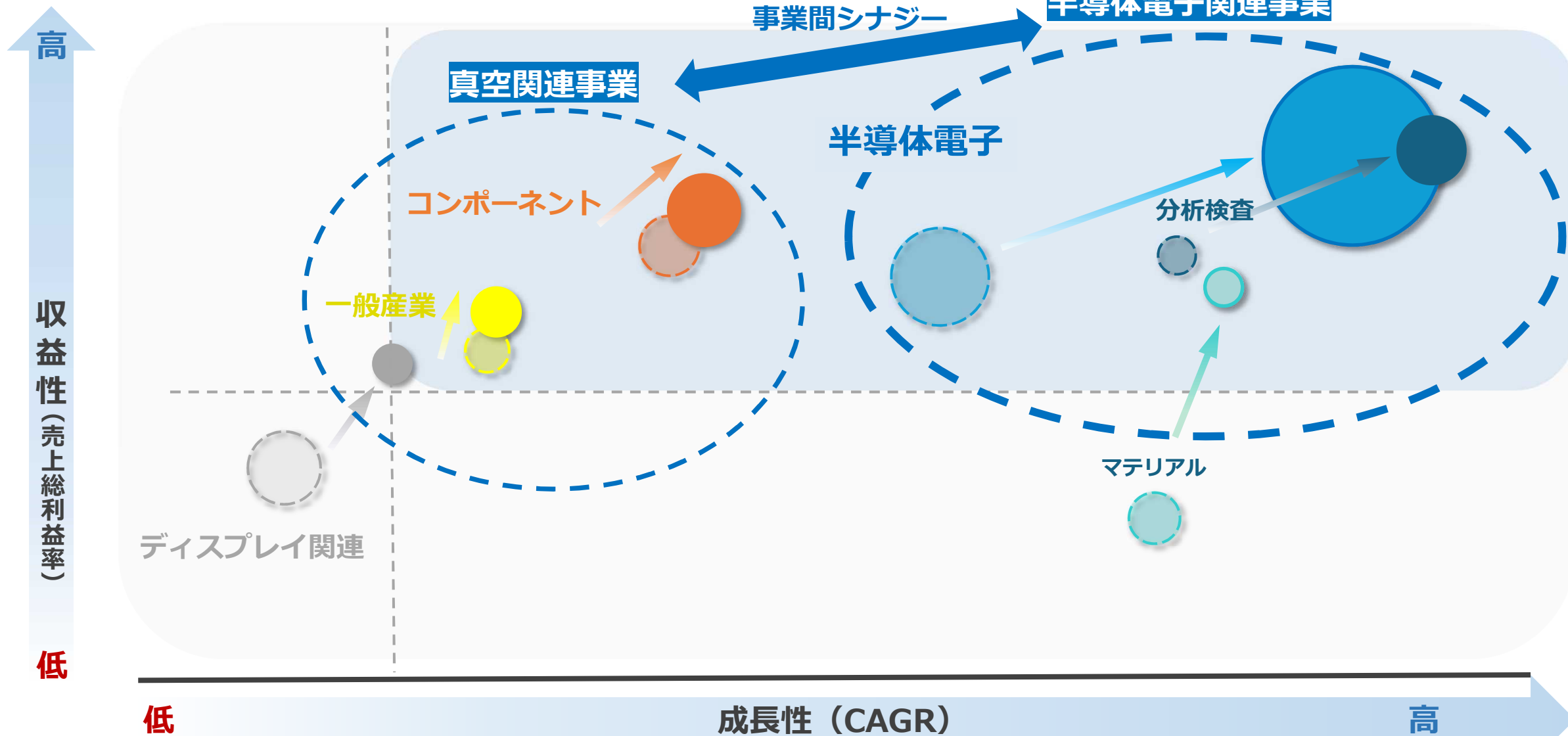
- 残渣除去：Wet処理からDry処理に切り替え
- 金属配線層：微細化に伴うPVDの採用加速
- Panel Level実装：本格導入開始

取り組み効果：受注高2.2倍*

*25/6期比の31/6期における効果

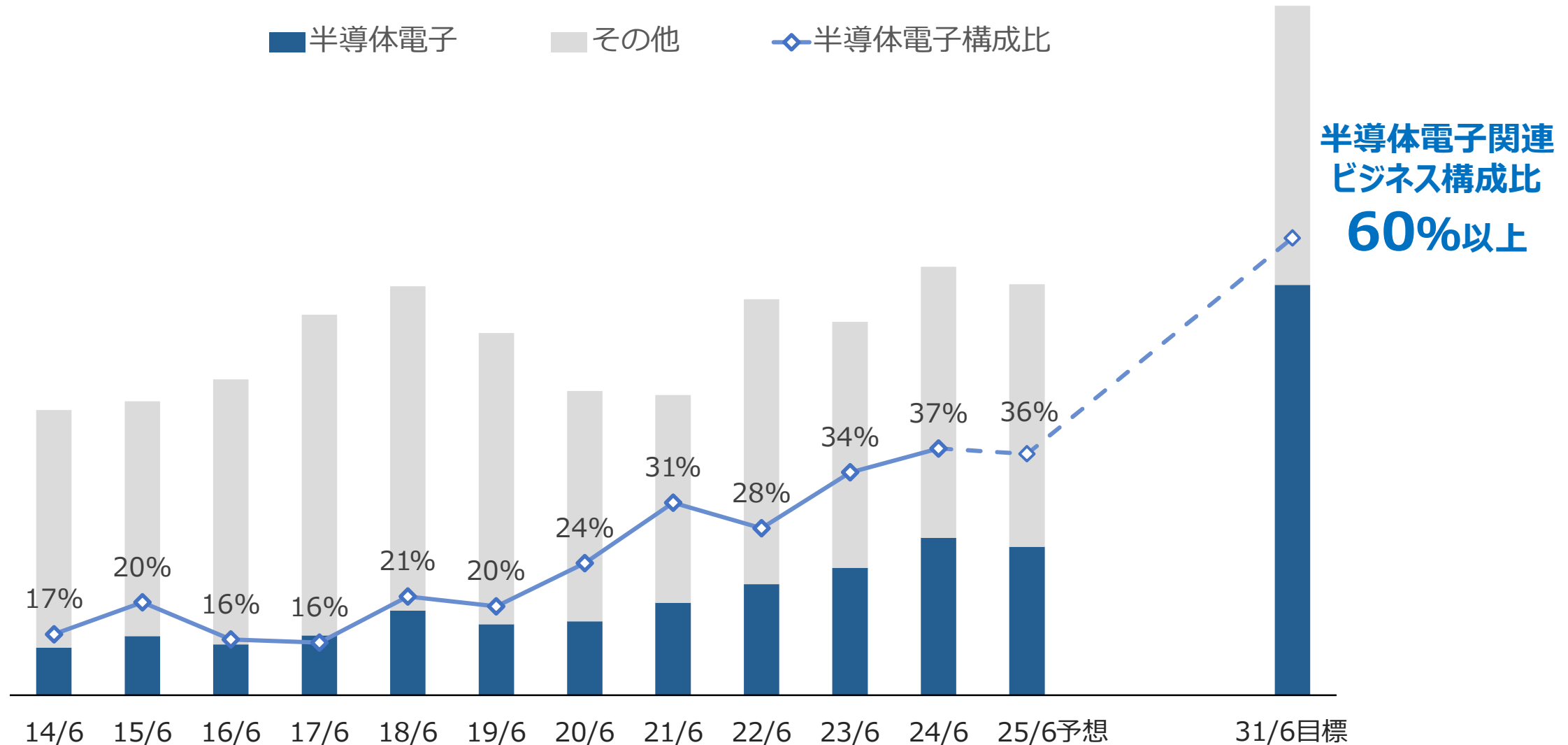
☆各用語の詳細解説は後段「用語集」ご参照

バブルの大きさ：売上高、矢印の先のバブルが将来の姿を示す、将来のバブルは31/6期時点の姿

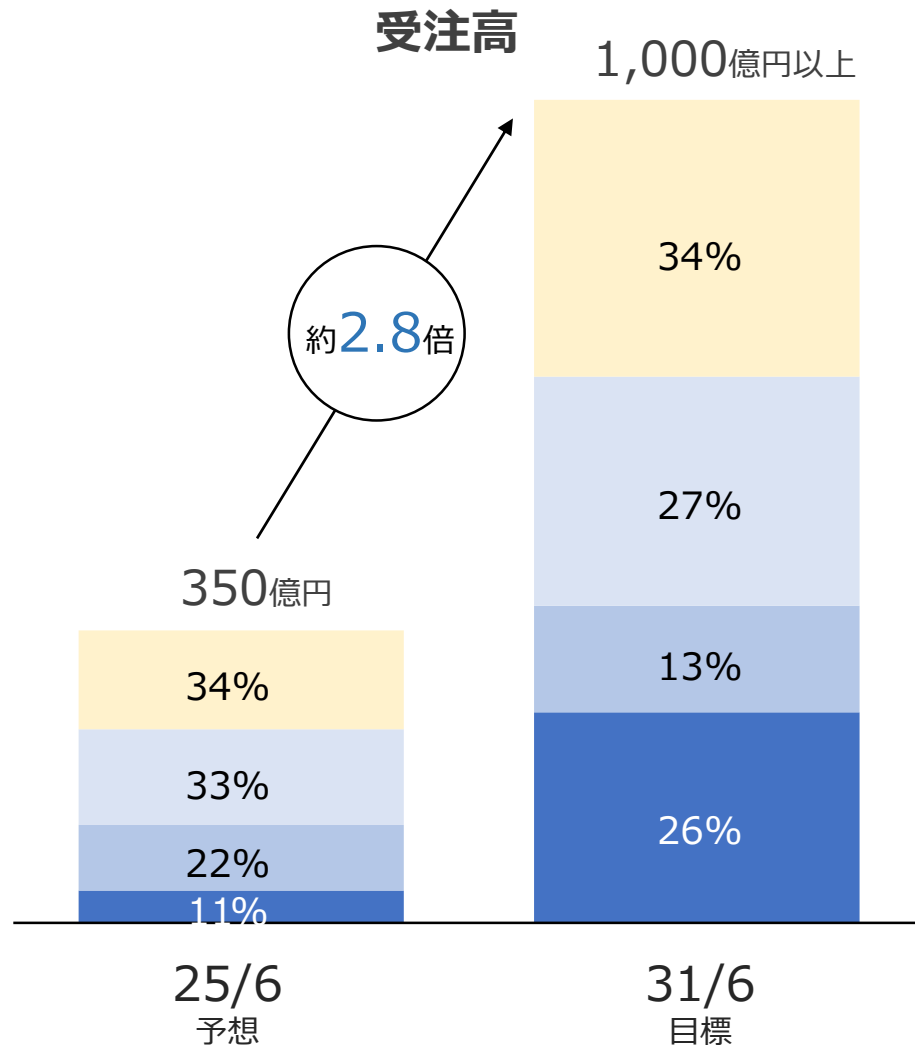


○ 23/6~25/6期 CAGR ● 25/6~31/6期 縮小事業を除くCAGR (年平均成長率)

▶ バリューアッププランにより獲得する筋肉質な体制を基に、半導体電子への注力加速・事業間シナジーを活用した新たな半導体電子関連ビジネスの創出により、高成長/高収益性を実現



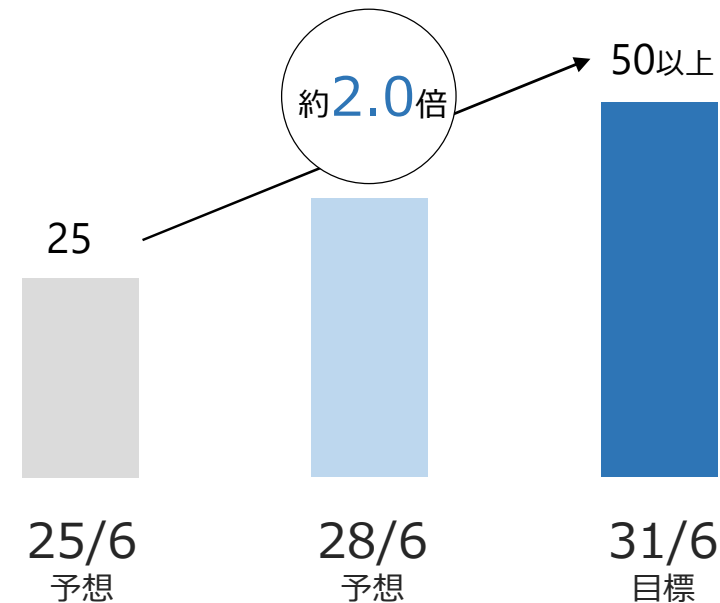
■ DRAM ■ NAND ■ Logic ■ CS(半導体)



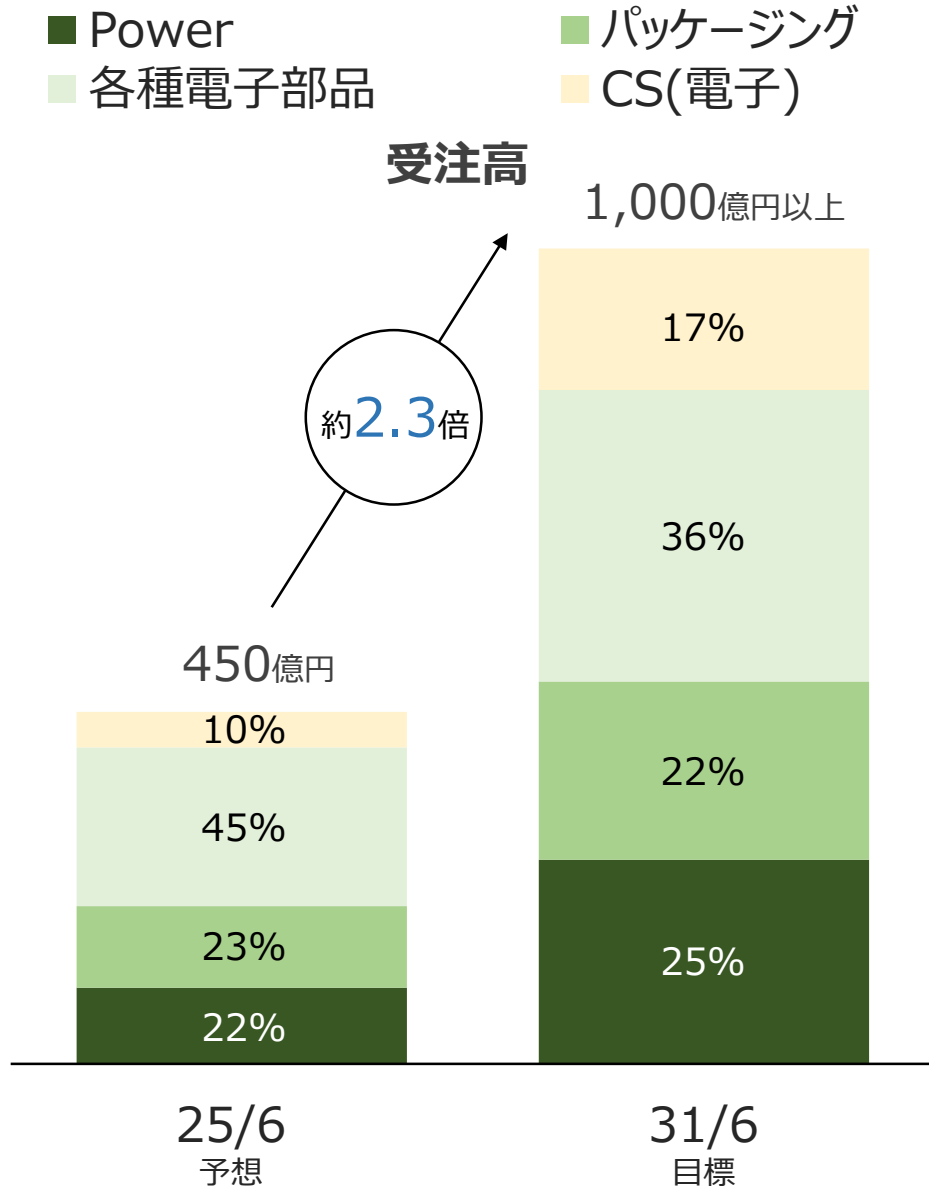
具体的な成長戦略

- ① HM技術の応用で高密度成膜による機能膜へ
- ② HM工程Top Makerの地位確立とCu配線波及
- ③ 先端Logic Cu配線 / Post-Cu配線工程獲得によるPVD Marketシェア拡大
- ④ CS事業拡大と深化

重要顧客POR*数



*Process of Record : 量産に使われる認定プロセス

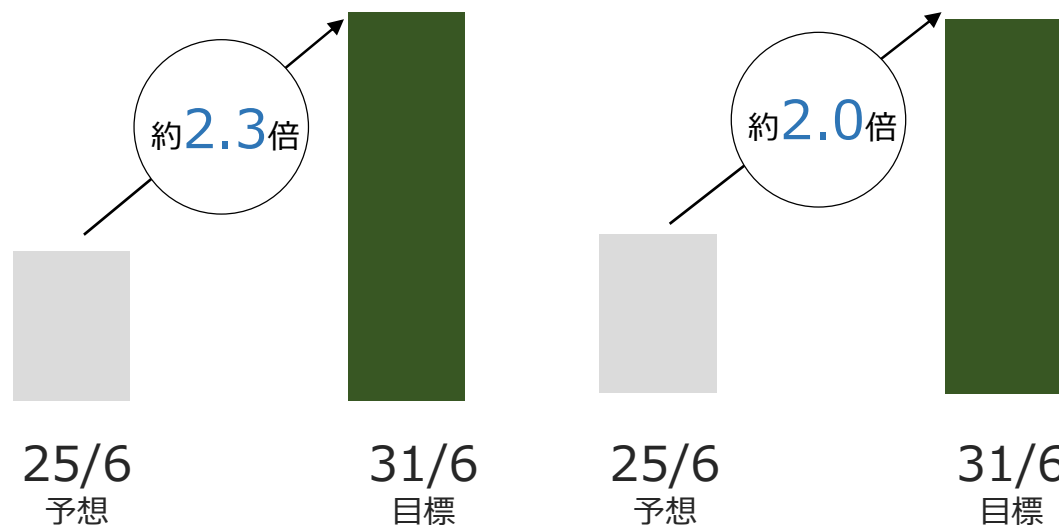


具体的な成長戦略

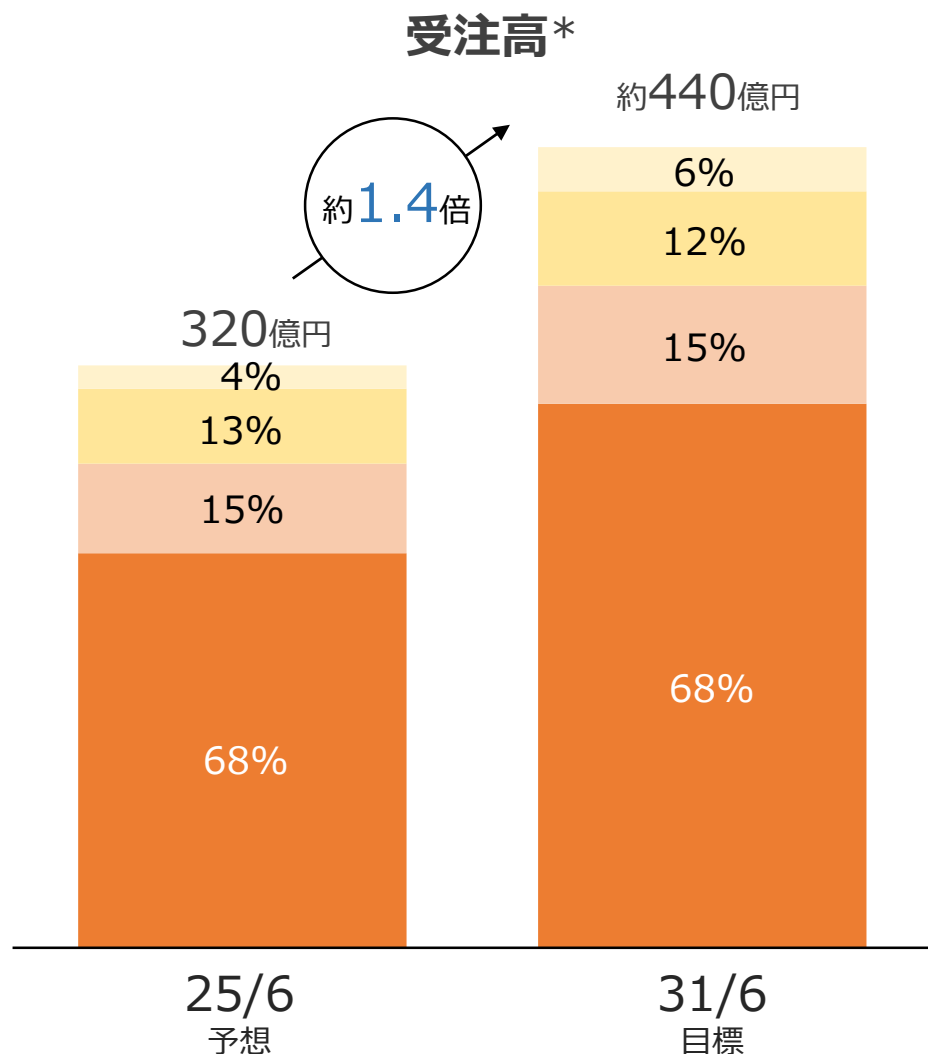
- ① SiC向けスパッタ・イオン注入に加え、GaN量産対応による適応拡大
- ② 先端パッケージングの投資拡大・新工程獲得
- ③ 通信機器の小型化に貢献するTFLN（薄膜リチウムニオブ酸）エッチング量産対応による光電融合ビジネス展開
- ④ CS事業拡大と深化

顧客数

商談件数



■ Pump
 ■ 電源
 ■ 計測
 ■ その他

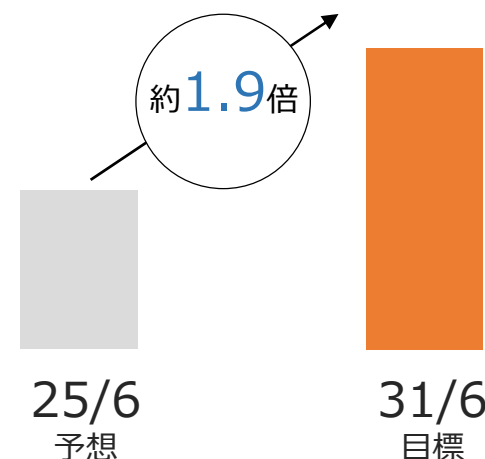


*リークテスト装置を除く

具体的な成長戦略

- ① 半導体・電子市場向け新製品の市場投入
(DC電源、RF電源、ドライポンプ、クライオポンプ)
装置事業とのシナジーにより小型・低消費電力・高い信頼性の製品開発を加速
- ② 低温機器関連
量子コンピュータ用の希釈冷凍機取組中
- ③ アライアンス等によるビジネス規模拡大

半導体・電子向け新製品の受注予測



項目	2025/6期 通期予想	2031/6期 目標
<p>売上高 (CAGR)</p> <p>半導体電子関連ビジネス*2</p>	2,500億円	<p>3,600億円 (CAGR 12%) *1</p> <p>(CAGR 17%)</p>
<p>営業利益率</p> <p>半導体電子関連ビジネス*2</p>	<p>10.8%</p> <p>13.0%</p>	<p>22%</p> <p>25%</p>
<p>半導体電子関連ビジネス*2</p> <p>売上高構成比</p>	36%	60%以上

*1 事業改革後の想定売上高をベースに計算

*2 管理会計に基づく数値

JCRより長期発行体格付「A」を新規取得

当社は、2025年4月25日付で株式会社日本格付研究所（JCR）より長期発行体格付「A」を新規取得しました。

本格付の取得は、事業内容や財務状況の健全性について第三者機関から客観的な評価を得ることで、経営の透明性向上と対外的な信用力強化を目的としています。

量子コンピューター向け次世代希釈冷凍機を開発、IBMと連携

量子コンピューターの超伝導量子ビットは極低温環境でのみ機能し、その冷却を支える希釈冷凍機の進化が重要です。当社は、希釈冷凍機や関連部品を自社開発・製造し、高冷却性能と拡張性を備えた製品を提供します。

日本の量子産業では海外製品の納期やメンテナンスの課題がある中、当社は国内生産体制を確立することで迅速なサポートを実現し、量子技術の発展を支えます。

また、IBMとの連携により次世代の希釈冷凍機システムを開発し、グローバルな量子コンピューティング産業の発展とサプライチェーンの強化に貢献しています。

経済産業省「健康経営優良法人2025（ホワイト500）」に認定

当社は、経済産業省と日本健康会議が実施する「健康経営優良法人2025（ホワイト500）」に認定され、国内グループ9法人も中小規模法人部門で認定されました。

引き続き、健康増進を重要な経営課題として取り組みを継続・発展させていきます。



CDP「気候変動2024」「水セキュリティ2024」で「B」スコアに認定

当社は、環境情報開示のためのシステムを有する国際的な非営利団体であるCDPが発表した「気候変動2024」および「水セキュリティ2024」において、「B」スコアを獲得しました。気候変動分野での「B」スコア獲得は2年連続となります。



- **PVD (Physical Vapor Deposition : 物理成膜)**
薄膜形成をする成膜技術 (当社の場合は主にスパッタ)
- **MHM (Metal Hard Mask : メタル・ハード・マスク)**
配線層形成を目的に、エッチング工程での加工用マスク膜 (当社はPVD : スパッタ膜)
- **FEOL (Front End of Line)**
トランジスタやキャパシタ、抵抗などをシリコンウェハ上に形成する半導体製造プロセスの初期段階を指す
- **BEOL (Back End of Line)**
FEOLで形成されたトランジスタなどのデバイスを接続するための配線や金属層を形成する半導体製造プロセスの後半工程を指す
- **GPU (Graphics Processing Unit : グラフィックス処理装置)**
画像や映像の描画を高速に処理するために設計されたプロセッサ。AI推論では大量の加減乗除演算など、反復的な計算用に適する
- **HBM (High Bandwidth Memory : 高帯域幅メモリ)**
複数のDRAMを垂直に積層し、シリコン貫通電極 (TSV) で接続することで、高速・高密度を実現した次世代メモリ技術
- **WLP (Wafer Level Package : ウェーハレベルパッケージ)**
ウェーハ (半導体基板) の状態でパッケージング工程を行う技術で半導体パッケージング技術の一つ
- **PLP (Panel Level Package : パネルレベルパッケージ)**
従来のウェーハレベルパッケージ (WLP) に代わり、四角いパネル状の基板を用いてパッケージングを行う半導体パッケージング技術の一つ
パネルに多数の半導体チップを基板全体に配置して一括してパッケージングする技術
- **POR (Process of Record)**
量産に使われる認定プロセス
- **HM (Hard Mask : ハード・マスク)**
PVD等で成膜されたマスク層

ULVAC